

レーザー学会東京支部 第14回 先進レーザー応用技術
「半導体光源デバイス研究とその応用技術」
開催のご案内

主催: (社) レーザー学会東京支部 (<http://www.soc.nii.ac.jp/laj/shibu/tokyo>)
開催日時: 2012年11月2日(金) 13:00-18:10 (セミナー終了後、懇親会)
会場: 慶應義塾大学矢上キャンパス 14棟 B2F マルチメディアルーム (<http://www.soc.nii.ac.jp/laj/shibu/tokyo>)
対象: 中堅技術者や新任開発リーダーから若手研究者、学生の方まで歓迎いたします。
趣旨: 近年、波長の多様化、高輝度化などの技術的な進展がみられる先端半導体光源の研究開発の
この分野の第一線でご活躍の先生方に解説いただきます。

プログラム: (講演タイトルは変更の場合があります)

13:00 レーザー学会 東京支部長挨拶

13:10 セミナー企画説明

第1講 シリコンフォトニクスにおける光デバイス研究開発動向
(13:20-14:05) ~ハイブリッド半導体レーザーを中心として~

第2講 通信用半導体量子ドットレーザーの開発と事業展開
(14:05-14:50)

第3講 AlGaN系深紫外LEDの進展と展望
(14:50-15:35)

15:35-15:55 休憩

第4講 PPLN導波路を用いた半導体レーザーの高効率波長変換と倍周波発生
(15:55-16:40)

第5講 ファイバーレーザー励起用高輝度半導体レーザーの進展
(16:40-17:25)

第6講 半導体レーザーの高効率ファイバー結合技術研究開発の進展
(17:25-18:10)

18:30- 懇親会 (日吉キャンパス 来往舎 ファカルティラウンジ)